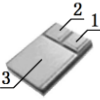


3DG101 型 NPN 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值				单位
			A	B	C	D	
极限值	P_{CM}		100				mW
	I_{CM}		20				mA
	T_{jm}		175				°C
	T_{stg}		-55~150				°C
直流参数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=0.1mA$	≥ 20	≥ 30	≥ 40	≥ 50	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=0.1mA$	≥ 15	≥ 20	≥ 30	≥ 40	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=0.1mA$	≥ 4.0				V
	I_{CBO}	$V_{CB}=10V$	≤ 0.03				μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=10V$	≤ 0.05				μA
	I_{EBO}	$V_{EB}=1.5V$	≤ 0.01				μA
	V_{BEsat}	$I_C=10mA$	≤ 1.0				V
	V_{CEsat}	$I_B=1mA$	≤ 0.35				
	h_{FE}	$V_{CE}=10V$ $I_C=0.5mA$	30~270				
交流参数	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=3mA$ $f_o=100MHz$	≥ 150				MHz
外形引线说明	 SMD-0.1  A3-01B(B1) 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极						
替代型号：3DG102、3DG6、3DG51、3DG026、3DG027、3DG031-033、3DG497、3DG13、3DG36、2SC29、2SC234、2SC235、2SC236、2SC250、3SC381							